

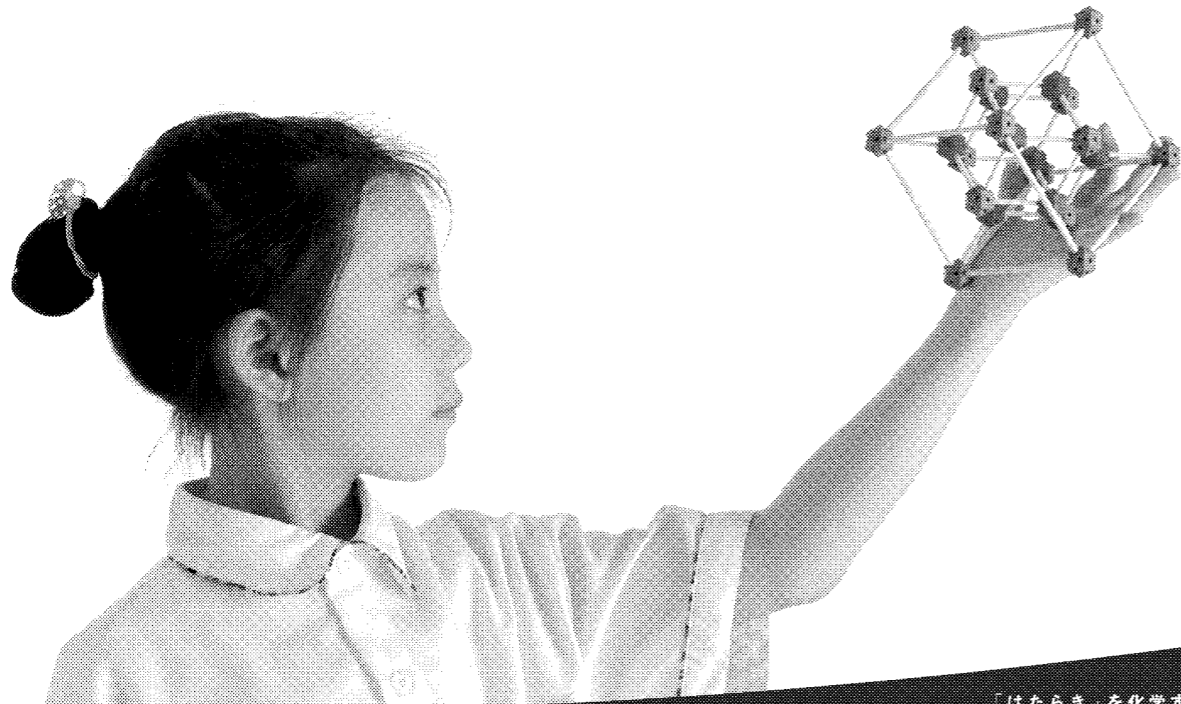
# 「はたらき」を化学する

人と地球の未来に役立つ、夢あふれる化学品を生み出したい。

もっと快適に、もっと地球にやさしく...

パフォーマンス・ケミカals  
その想いを胸に「はたらきの化学品」を開発し続けています。

今より、もっと素敵明日をみつめて、チャレンジを続けます。

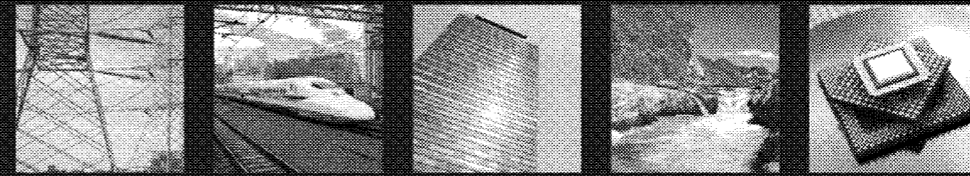


本社 / 〒605-0995 京都市東山区一橋野本町11-1  
http://www.sanyo-chemical.co.jp/



# 人と技術の未来をひらく

社会の基盤を支えてきた確かな技術力で  
未来からのリクエストをカタチにしています。



〒615-8686 京都市右京区梅津高畝町47番地  
TEL (075) 861-3151 (代表) FAX (075) 864-8312 http://nissin.jp

# 学が集積生かす



京都市東山区一橋野本町11-1  
京大桂ベンチャープラザ  
京大桂ベンチャープラザは、京大桂ベンチャープラザの機能を最大限に活用し、産学連携を推進する。京大桂ベンチャープラザは、京大桂ベンチャープラザの機能を最大限に活用し、産学連携を推進する。

京大桂ベンチャープラザは、京大桂ベンチャープラザの機能を最大限に活用し、産学連携を推進する。京大桂ベンチャープラザは、京大桂ベンチャープラザの機能を最大限に活用し、産学連携を推進する。

### 「京大に密着」が強み

#### 京大桂ベンチャープラザ

京都市西部の丘陵地に立地し、京都大学大学院工学研究科の施設が隣接する京大桂ベンチャープラザ(京都市西京区)は、同キャンパスに隣接するインキュベーション施設だ。産学公の連携を取り組む意欲的な研究開発型企業が、延べ約70社入居している。強みは「京大に密着した技術指導や共同研究、研究成果の情報提供など得られる」(同プラザの江村寛計コーディネーター)高度な支援体制、入居社員のうち19社が最先端の研究テーマで京大と連携し、起業や事業化を目指している。

テーマは携帯電話用の燃料電池、高耐久性の紫外線センサー、チタン合金の加工技術、超微細のナノ技術など、多岐にわたる。「自前で研究開発するインテリジェントな事業化にめどをつけた。入居上限5年で、継続可能。東京や新潟の企業も受け入れてきた。技術的にゼロから出発し、事業化にこぎ着けた事例もある」(同)。

入居企業の技術や経営を側面から支えるのが、大手の商社やメーカーのOBから採用した技術者ら5人のインキュベーション・マネージャー(IEM)だ。IEMは経験や人脈で連携と技術をバックアップし、コーディネーターも資金・事業計画・販路・宣伝を支援する。

# 文理融合型で実施

同志社大学は、教員の4分の3が人文社会系という特色を生かし、文理融合型の産学官連携活動を展開する。理工系と文系の担当コーディネーターをそれぞれ配置し、幅広い分野で学際的な協働も促す。研究開発推進機構が連携を統括、外部との窓口となるリエンオフィスは、2012年に開設10年を迎えた。京大桂ベンチャープラザ(京都府京田辺市)内には起業家育成施設「Design Lab」を06年に開設。設置主体の中小企業基盤整備機構が連携を統括、外部との窓口となるリエンオフィスは、2012年に開設10年を迎えた。京大桂ベンチャープラザ(京都府京田辺市)内には起業家育成施設「Design Lab」を06年に開設。設置主体の中小企業基盤整備機構が連携を統括、外部との窓口となるリエンオフィスは、2012年に開設10年を迎えた。

# EV量産、10月開始

## 13年度に100台を計画

燃料電池で事業化を目指す(中央は入居企業の開発者)

同志社大学は、教員の4分の3が人文社会系という特色を生かし、文理融合型の産学官連携活動を展開する。理工系と文系の担当コーディネーターをそれぞれ配置し、幅広い分野で学際的な協働も促す。研究開発推進機構が連携を統括、外部との窓口となるリエンオフィスは、2012年に開設10年を迎えた。京大桂ベンチャープラザ(京都府京田辺市)内には起業家育成施設「Design Lab」を06年に開設。設置主体の中小企業基盤整備機構が連携を統括、外部との窓口となるリエンオフィスは、2012年に開設10年を迎えた。

# 産・学・公

京都のネットワーク

産・学・公のネットワークは、産学官連携を推進する。京大桂ベンチャープラザは、京大桂ベンチャープラザの機能を最大限に活用し、産学連携を推進する。京大桂ベンチャープラザは、京大桂ベンチャープラザの機能を最大限に活用し、産学連携を推進する。

品名	絶対最大定格		電気的特性 (Ta=25°C)				パッケージ
	直流逆方向電圧 Vr(V)	順方向電流 If(A)	順方向電圧 Vf(V)		逆方向電流 Ir(μA)		
SCS106AG/AM	600	6	Typ. 1.5	If(A) 6	Max. 120	Vr(V) 600	TO-220AC 2L/ TO-220FM 2L
SCS108AG/AM	600	8	1.5	8	160	600	
SCS110AG/AM	600	10	1.5	10	200	600	
NEW SCS210AG/AM	600	10	1.35	10	200	600	
SCS112AG/AM	600	12	1.5	12	240	600	
SCS120AG	600	20	1.5	20	400	600	
SCS105KG	1200	5	1.5	5	160	1200	TO-220AC 2L
SCS110KG	1200	10	1.5	10	200	1200	
SCS120KG	1200	20	1.5	20	400	1200	
SCS120AE2	600	*10/20	1.5	10	200	600	
NEW SCS220AE2	600	*10/20	1.35	10	*200/400	600	TO-247
SCS140AE2	600	*20/40	1.5	20	*400/800	600	
SCS110KE2	1200	*5/10	1.5	5	*100/200	1200	
SCS120KE2	1200	*10/20	1.5	10	*200/400	1200	

品名	BVdss(V)	Rds(on)(mΩ)	パッケージ	
				1パッケージSIC-MOSFET
NEW SCT2080KE (SIC-MOSFET)	1200	80	TO-247	
NEW SCH2080KE (SIC-MOSFET-SIC-SBD)	1200	80	TO-247	

品名	Vdss(V)	Ib(A)	パッケージ	
				●ハーフブリッジ回路
BSM120D12P2C005	1200	120	TO-247	

◎リカバリ時間が短い ◎ロスが少ない高速スイッチングが可能  
◎インゴットからパワーデバイスまで一貫した製造・開発体制で高品質

## ロームのSiCパワーデバイス & パワー半導体

次世代SiCパワーモジュール (研究開発中)

「フルSiC」パワーモジュール

SIC-SBD TO-220FM 2L

SIC-SBD TO-220AC 2L

SIC-MOSFET TO-247

次世代SiCパワーモジュール 開発中

ROHM SEMICONDUCTOR

## Siパワー半導体も 続々ラインアップ

活躍領域に合わせて進化続ける、ロームの高性能パワーデバイス

高耐圧 MOSFET RCシリーズ

高速スイッチング 高耐圧MOSFET

高速trr MOSFET PrestoMOS™ シリーズ

ショットキー バリアダイオード RBQシリーズ

パワーファスト リカバリダイオード RFシリーズ

ROHM SEMICONDUCTOR

ローム株式会社 www.rohm.co.jp  
〒615-8585 京都市右京区西院清岡町21  
TEL.075-311-2121